










	<h2 style="color: red;">FQD1N60TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD1N60TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
	Datenblätter:	1.FQD1N60TM.pdf 2.FQD1N60TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD1N60TM ist neu im Original, Suche FQD1N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD1N80 FAIRCHILD FQD1N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD1N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>
 <p>FQD1N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p>FQD1N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

FQD17P06TF FQD18N20V2TM FQD19N10LTM D FQD1N50B FQD1N60CTF FQD1N60TM FQD20N06 FQD20N06LETM FQD20N06LTU FQD24N08	FQD17P06TF FQD18N20V2TM FQD19N10TF FQD1N50TF FQD1N60CTM FQD1N80TM D FQD20N06-NL FQD20N06LTF FQD20N06TF FQD24N08TF	FQD17P06TM D FQD19N10 FQD19N10TF FQD1N50TF FQD1N60CTM D FQD1N80TM FQD20N06L FQD20N06LTF FQD20N06TF FQD24N08TF	D FQD17P06TM FQD19N10L FQD19N10TM FQD1N60C FQD1N60TF FQD1P50TM FQD20N06LE FQD20N06LTM D FQD20N06TM FQD24N08TM	FQD18N20V2 FQD19N10LTM FQD19N10TM FQD1N60CTF FQD1N60TF FQD1P50TM FQD20N06LETM FQD20N06LTM FQD20N06TM FQD24N08TM
---	--	--	--	--

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited